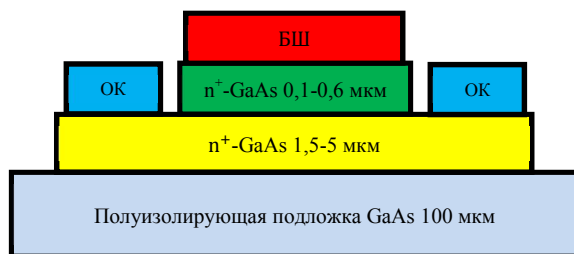




Процесс DBS

Технология изготовления СВЧ МИС на основе GaAs диодов с барьером Шоттки

Сечение pin-диода



Технология изготовления СВЧ МИС на основе GaAs диодов с барьером Шоттки (процесс DBS) подходит для разработки преобразовательных схем и схем ограничителей мощности, работающих на частотах до 140 ГГц и выше. Технология позволяет формировать диоды с барьером Шоттки, тонкопленочные резисторы, МДМ-конденсаторы, спиральные катушки индуктивности и сквозные металлизированные отверстия. Технология доступна в режиме foundry.

Параметры процесса DBS

Элемент	Параметр	Ед. изм.	Значение
Диоды	Диаметр	мкм	не менее 6
	Пробивное напряжение	В	не менее 5
	Показатель идеальности		1,1–1,3
	Сопротивление	Ом	3–8
МДМ-конденсаторы	Удельная емкость	пФ/мм ²	420
	Пробивное напряжение	В	40
	Максимальное рабочее напряжение	В	20
Незисторы	Слоевое сопротивление	Ом/кв	20, 50
Подложка	Толщина	мкм	100

Возможно изготовление диодов, диодных сборок и МИС с балочными выводами.

С использованием процесса DBS были разработаны МИС ММ602, ММ603, ММ605 и др.

По вопросам заказа и уточнения параметров обращаться по e-mail: mmic@niipp.ru или по тел. (3822) 28-82-48.

С номенклатурой МИС СВЧ можно ознакомиться по ссылке <http://www.niipp.ru/catalog/> в разделе «Монолитные интегральные схемы СВЧ».